

2011. vizsgák

06.01:

1. A szokványos, hagyományos bipoláris IC tranzisztor keresztmetszete.
2. Az ionimplantáció elve, felhasználási lehetőségei az IC technológiában.
3. Maszk programozott MOS ROM (kapcsolási rajz, layout)
4. Árokkapacitásos, HighC RAM cella.

4. feladathoz tipp: Szerintem ez arra vonatkozik, hogy a kapacitás az árokban van (trench DRAM) vagy a chip tetején (stackelt DRAM).

06.08:

1. npn-tranyó
nde, nab, ndc megadva, bázis szélesség megadva
a) nyitófeszültség u_{bediff}
b) hol jön létre a tér, mekkora a maximuma
c) BC átmenetnél milyen jelentősége van a térnek
igazából még ennél is többet csavartak rajta, de a lényeg, hogy ilyesmire is lehet most már számítani
2. CMOS inverter
3. EPROM
4. 2 polys DRAM